Ширина запрещенной зоны твердых растворов (Feln₂S₄)_{1-x} (ln₂S₃)_x

© И.В. Боднарь¶

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 220013 Минск, Беларусь

(Получена 19 декабря 2013 г. Принята к печати 24 января 2014 г.)

На монокристаллах соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворах (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x, выращенных методом Бриджмена, при 80 и 295 К изучены спектры пропускания в области края фундаментальной полосы поглощения. По полученным спектрам определена ширина запрещенной зоны соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x, а также построена ее концентрационная зависимость. Установлено, что ширина запрещенной зоны с составом х изменяется нелинейно и описывается квадратичной зависимостью.

1. Введение

В последние годы значительное внимание уделяется изучению магнитных полупроводников типа MB2III С^{VI} $(M - Mn, Fe, Co, Ni; B^{III} - Al, Ga, In; C^{VI} - S,$ Se, Te) [1-3]. Указанные соединения являются новыми и практически малоизученными материалами. В работах [4-13] нами были исследованы оптические и магнитные свойства некоторых из указанных соединений, а также твердые растворы на их основе. В настоящей работе впервые представлены результаты исследования спектров пропускания в области края собственного поглощения монокристаллов тройных соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x. В [12] нами было показано, что твердые растворы $(FeIn_2S_4)_{1-x}(In_2S_3)_x$ являются перспективными материалами для создания широкополосных фотопреобразователей.

2. Методика эксперимента

Монокристаллы соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x выращивали направленной кристаллизацией расплава (метод Бриджмена) из предварительно синтезированных двухтемпературным методом поликристаллических слитков. Полученные слитки измельчали и перегружали в двойные кварцевые ампулы, из которых внутренняя ампула заканчивалась цилиндрическим капилляром, который обеспечивал формирование монокристаллической затравки. К наружной ампуле снизу приваривали кварцевый стержень, служивший держателем. После вакуумирования ампулы до остаточного давления $\sim 10^{-3}$ Па ее помещали в вертикальную однозонную печь с заданным температурным градиентом, в которой проводили выращивание монокристаллов. Температуру печи повышали до ~ 1400 К и для гомогенизации расплава выдерживали при этой температуре 2ч. После указанного времени выдержки проводили направленную кристаллизацию расплава, понижая температуру печи со скоростью ~ 2 К/ч до полного затвердевания расплава. Для гомогенизации полученных слитков их отжигали при 1020 К в течение 300 ч. Выращенные в таких условиях монокристаллы имели диаметр $\sim 14-16$ мм и длину $\sim 40-45$ мм, были однородными и гомогенными.

Состав выращенных кристаллов определяли с помощью микрозондового рентгеноспектрального анализа. В качестве возбудителя тормозного рентгеновского излучения образца использовали электронный луч растрового электронного микроскопа "Stereoscan-360". В качестве анализатора рентгеновского спектра использовали рентгеновский спектрометр "AVALON-8000".

Равновесность соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и гомогенность твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x определяли рентгеновским методом. Угловые положения линий дифракционного спектра записывали на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М в Cu K_{α} -излучении с графитовым монохроматором.

Спектры пропускания соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов(FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x в области края фундаментального поглощения регистрировали на спектрофотометрах "Cary-500" и "Весктапл-5240". Для измерений спектров пропускания вырезали плоскопараллельные пластинки перпендикулярно оси роста кристаллов, которые затем механически шлифовали и полировали с двух сторон до толщин ~ 20 мкм. Для снятия нарушенного слоя, образовавшегося при механической обработке кристаллов, непосредственно перед измерениями спектров образцы подвергали обработке в травителе состава Br₂:C₂H₅OH = 1:3.

3. Результаты и их обсуждение

Результаты микрозондовых рентгеноспектральных измерений показали, что содержание компонент в выращенных кристаллах соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворах (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x удовлетворительно согласуется с заданным составом в исходной шихте.

Проведенные рентгеновские исследования показали, что на дифрактограммах как соединений $FeIn_2S_4$, In_2S_3 , так и твердых растворов на их основе присутствуют индексы отражений, характерные для кубической структуры шпинели. Разрешение высокоугловых линий на ука-

[¶] E-mail: chemzav@bsuir.by



Рис. 1. Спектры пропускания монокристаллов FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x} (In₂S₃)_x: I - x = 0.0, 2 - x = 0.2, 3 - x = 0.4, 4 - x = 0.6, 5 - x = 0.8, 6 - x = 1.0, a - 80 K, b - 295 K.

занных дифрактограммах свидетельствует о равновесности соединений и гомогенности твердых растворов. Параметры элементарной ячейки, рассчитанные методом наименьших квадратов, равны $a = 10.612 \pm 0.005$ Å для соединения FeIn₂S₄ и $a = 10.772 \pm 0.005$ Å для In₂S₃. Изменение параметра a с составом x осуществляется линейно в соответствии с законом Вегарда [14].

Спектры пропускания кристаллов соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x при 80 и 300 К представлены на рис. 1, *а*, *b*. Видно, что указанные спектры имеют сложный характер в исследованной области длин волн. За исключением соединения In₂S₃, они состоят из трех участков: на первом участке начинается рост величины пропускания с достижением максимума, затем происходит уменьшение величины пропускания с достижением минимума, после чего происходит дальнейший рост величины пропускания. Аналогичный характер поведения ранее нами наблюдался и для твердых растворов на основе соединений MnIn₂S₄ и FeIn₂S₄ [9].

Из зарегистрированных спектров пропускания (T_{opt}) рассчитывали коэффициент поглощения (α) по формуле, учитывающей многократное внутреннее отражение в

плоскопараллельном образце:

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left\{ \frac{(1-R)^2}{2T} + \sqrt{\left[\frac{(1-R)^2}{2T}\right]^2 + R^2} \right\}, \quad (1)$$

где *R* — коэффициент отражения, *d* — толщина образца.

В связи с отсутствием теоретических расчетов зонной структуры указанного класса материалов провести интерпретацию наблюдаемых полос в области края собственного поглощения весьма сложно. Однако можно предположить, что рост пропускания в области длин волн 500–1000 нм (для разных x) связан с началом межзонных переходов в исследованных кристаллах. Увеличение пропускания в области длин более 1000 нм указывает на то, что край собственного поглощения как в кристаллах тройных соединений FeIn₂S₄ и In₂S₃, так и твердых растворах на их основе обусловлен прямыми межзонными переходами.

На рис. 2, *а*, *b* представлены спектральные зависимости $(\alpha\hbar\omega)^2$ от энергии фотона $(\hbar\omega)$ для соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x. Видно, что указанные зависимости имеют четко выраженные прямолинейные участки, что свидетельствует



Рис. 2. Спектральные зависимости $(\alpha \hbar \omega)^2$ от $\hbar \omega$ для монокристаллов FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x: 1 - x = 0.0, 2 - x = 0.2, 3 - x = 0.4, 4 - x = 0.6, 5 - x = 0.8, 6 - x = 1.0, a - 295 K, b - 80 K.

(как и рентгеновские данные) о равновесности выращенных монокристаллов соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и гомогенности твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x. Ширину запрещенной зоны определяли экстраполяцией прямолинейных участков зависимости $(\alpha\hbar\omega)^2$ от энергии фотона $(\hbar\omega)$ до пересечения с осью абсцисс.



Рис. 3. Концентрационные зависимости ширины запрещенной зоны для кристаллов твердых растворов $(\text{FeIn}_2\text{S}_4)_{1-x}(\text{In}_2\text{S}_3)_x$. *I* — 80 K, *2* — 295 K.

Полученные нами данные E_g для соединения FeIn₂S₄ составляют 1.450 (80 K) и 1.3770 эВ (295 K) и 2.219 (80 K) и 2.090 эВ (295 K) для In₂S₃. Наши данные для исходных соединений удовлетворительно согласуются с данными [15]. Температурные коэффициенты ширины эапрещенной зоны ($\partial E_g / \partial T$) равны $3.4 \cdot 10^{-4}$ и $6.0 \cdot 10^{-4}$ эВ/К для FeIn₂S₄ и In₂S₃ соответственно.

Концентрационные зависимости ширины запрещенной зоны для твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x при 80 и 295 К представлены на рис. З. Видно, что изменение E_g с составом x имеет нелинейный вид, что характерно для твердых растворов, образованных сложными полупроводниковыми соединениями [16–18].

Для твердых растворов (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x нелинейность в изменении $E_g(x)$ приближенно может быть описана квадратичной зависимостью следующего вида:

$$E_g(x) = E_A + (E_B - E_A - c)x + cx^2,$$
 (2)

где E_A и E_B — ширина запрещенной зоны исходных соединений; c — параметр нелинейности, который характеризует степень отклонения от линейной зависимости E_g для среднего состава (x = 0.5), определяемый из выражения

$$c = 4\Delta E(x = 0.5),\tag{3}$$

где

$$\Delta E = (E_A + E_B)/2 - E_g(x = 0.5).$$

Концентрационные зависимости ширины запрещенной зоны для твердых растворов $(FeIn_2S_4)_{1-x}(In_2S_3)_x$ при 80 и 295 К аналитически описываются следующими функциями

$$E_g^{80}(x) = 1.450 + 0.391x + 0.378x^2,$$

 $E_g^{295}(x) = 1.377 + 0.337x + 0.376x^2.$

Для объяснения отклонения $E_g(x)$ от линейности используются два приближения: диэлектрическая модель Ван Вехтена и Бергштрессера [19] и модель псевдопотенциала Хилла и Ричардсона [20]. Авторы первой модели считают, что определяющую роль в отклонении $E_g(x)$ от линейности в твердых растворах играют флуктуации кристаллического потенциала, вызванные хаотическим расположением замещающих атомов. Авторы второй модели считают, что это отклонение является следствием нелинейных свойств кристаллического поля.

Обе представленные модели, хотя и исходят из различных физических предпосылок, удовлетворительно описывают экспериментальные данные для твердых растворов как на основе бинарных соединений, так и на основе тройных соединений.

Рассчитанные значения E_g по соотношению (2) на рис. З представлены сплошными линиями. Видно, что между расчетными и экспериментальными величинами имеется вполне удовлетворительное согласие.

4. Заключение

Впервые на монокристаллах соединений FeIn₂S₄, In₂S₃ и твердых растворах (FeIn₂S₄)_{1-x}(In₂S₃)_x исследованы спектры пропускания в области края собственного поглощения при 80 и 295 К. Определена ширина запрещенной зоны указанных материалов и построена ее концентрационная зависимость. Установлено, что E_g с составом x носит нелинейный характер. Проведен расчет зависимости $E_g(x)$ в приближение моделей Ван Вехтена и Бергштрессера и Хилла и Ричардсона. Показано удовлетворительное согласие между экспериментальными и расчетными величинами.

Список литературы

- R.J. Hill, J.R. Craig, G.V. Gibbs. J. Phys. Chem. Sol., 39, 1105 (1978).
- [2] J.L. Soubeyrouox, D. Fiorani, E. Agostinelli, S. Bhargava, G.L. Dorman. J. de Phys. C8, 49, 117 (1988).
- [3] S. Reil, H. Haeuseler. J. Alloys Comp., 270, 83 (1998).
- [4] И.В. Боднарь. ЖНХ, 55, 896 (2010).
- [5] I.V. Bodnar, I.A. Victorov, V.M. Dabranski, M.A. Osipova. Phys. Status Solidi C, 6, 1130 (2009).
- [6] V. Bodnar, S.V. Trukhanov, S.A. Pauliukavets, M.A. Novikova. J. Spintronics and Magnetic Nanomater, 1, 1 (2012).
- [7] И.В. Боднарь, С.А. Павлюковец. ФТП, 45, 1450 (2011).
- [8] И.В. Боднарь, М.А. Новикова, С.В. Труханов. ФТП, 47, 850 (2013).

- [9] И.В. Боднарь. ФТП, **46**, 44 (2012).
- [10] И.В. Боднарь, С.В. Труханов. ФТП, 45, 1464 (2011).
- [11] И.В. Боднарь, С.А. Павлюковец, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь. ФТП, 43, 1553 (2009).
- [12] И.В. Боднарь, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков. ФТП, 44, 39 (2010).
- [13] И.В. Боднарь, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь. ФТП, 43, 1549 (2009).
- [14] И.В. Боднарь, Ю.А. Федотова, М.А. Новикова. Неорг. матер., 47, 156 (2011).
- [15] Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник, под ред А.В. Новоселовой, В.Б. Лазарева (М., Наука, 1979).
- [16] И.В. Боднарь. ЖНХ, 43, 2090 (1998).
- [17] И.В. Боднарь. Неорг. матер., 36. 796 (2000).
- [18] И.В. Боднарь, В.В. Шаталова. ФТП, 46, 1146 (2012).
- [19] J.A. Van Vechten, T.K. Bergstresser. Phys. Rev. B, 1, 3351 (1970).
- [20] R. Hill. J. Phys. C, 7, 521 (1974).

Редактор Т.А. Полянская

Energy band of gap $(Feln_2S_4)_{1-x}(In_2S_3)_x$ solid solutions

I.V. Bodnar

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 220027 Minsk, Belarus

Abstract The transmission spectra were studied in the region of the self-absorption edge of the single crystals of FeIn₂S₄, the In₂S₃ compounds and (FeIn₂S₄)_{1-x} (In₂S₃)_x solid solutions grown by Bridgman method. The band gap was determined by the spectra obtained and the band gap concentration dependence was also drawn/As it is revealed the band gap width with *x*-composition changes nonlinearly and can be described by the quadratic dependence.